5　その他
⑴　上記４の説明会に出席を希望する者は、平成27年４月８日正午までに下記⑵まで書面により申し込みをすること（様式適宜）。
なお、申し込み方法は、ＦＡＸ、郵送、手交のいずれかによる。
⑵　申込先　外務省国際協力局政策課　榎本絵里子　電話03―3580―3311　内線3095　ＦＡＸ03―5157―1861
⑶　この調達計画の詳細は調達説明書による。
6　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 73
⑵　Nature and quantity of the services to be required : Advertising services, 1 set.
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Time-limit for the submission of the requested material : 11 : 00 a.m. April 28, 2015
⑸　Contact point for the notice : Eriko Enomoto, ODA Policy and Management Division, International Cooperation Bureau, Ministry of Foreign Affairs, 2―1―1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8919 Japan. TEL 03―3580―3311 Ext. 3095 FAX 03―5157―1861

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 27 年３月 26 日
国立大学法人東北大学理事　佃　　良彦
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第 12 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　高機能合金積層薄膜形成用スパッタ装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成27年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　ＤＣ及びＲＦマグネトロンスパッタリング法による薄膜の堆積ができること
Ｂ　スパッタ室の到達真空度が超高真空となること
Ｃ　ロードロック室と基板搬送機構を備えること
Ｄ　３インチ以上の基板に薄膜を堆積させられること
Ｅ　プログラム制御により20枚以上のウェハを連続して処理できること
Ｆ　13元以上のカソードを備え、うち少なくとも１元はＲＦスパッタリング成膜ができること
Ｇ　３元以上のカソードを同時に放電させることによる同時スパッタリング成膜ができること
Ｈ　ＲＦ基板バイアスがかけられること
Ｉ　堆積された薄膜の膜厚の面内均一性は３インチウェハ内で±２％以内となること
Ｊ　400℃以上に基板を加熱しながら成膜できること
Ｋ　スパッタリングの際Ar、Kr、Xe、Ｎ２ガスを供給できること
Ｌ　300℃以上の熱処理後において、０～30℃の測定温度範囲において、以下の特性を示す垂直磁化容易軸を有するCoFeBとMgOを含む磁気トンネル接合膜をウェハ上に90分以内で作製できること
・自由層と固定層の反転磁場に50mT以上の差異がある
・トンネル磁気抵抗比が100％以上である
・抵抗と接合面積の積（ＲＡ）が15Ωμ㎡以下である
・上記ＲＡのばらつきがウェハ中央40mm角の範囲において±５％以下である
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成27年４月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　菊地　　崇　電話022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成27年３月26日から平成27年４月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成27年４月６日10時30分
⑵　開催場所　東北大学電気通信研究所ナノ・スピン実験施設４階Ａ401
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Sputtering machine for high-functionality alloy multilayer thin film deposition 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Thin films can be deposited by DC and RF magnetron sputtering.
B　Base pressure of sputtering chamber is in ultrahigh vacuum level.
C　Load-lock chamber and substrate transfer system are equipped.
D　Thin films can be deposited on wafer with the diameter of more than 3 inches.
E　More than 20 wafers can be sequentially processed by program control.
F　More than 13 cathodes are equipped, where one of cathodes at least should allow for RF sputtering.
G　Co-sputtering deposition using more than 3 cathodes is possible.
H　RF bias can be applied to substrate.
I　Uniformity of deposited film over 3 inches in diameter becomes less than ±2%.
J　Temperature of substrate can be elevated to more than 400 ℃ during deposition.
K　Ar, Kr, Xe, N2 gases can be supplied for sputtering.
L　Magnetic tunnel junction film with perpendicular magnetic easy axis that comprises CoFeB and MgO and that shows the following properties at the measurement temperature ranging from 0 to 30 ℃ after annealing at more than 300 ℃ can be prepared on wafer within 90 minutes.
・Difference between reversal fields of free layer and fixed layer is more than 50 mT.
・Tunnel magnetoresistance ratio is more than 100%.
・Product of resistance and junction area (RA) is less than 15 Ωμ㎡.
・Variability of RA in the central region of wafer with 40-mm square is less than ±5%.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　27 April, 2015
⑹　Contact point for the notice : Takashi Kikuchi, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 27 年３月 26 日
国立大学法人徳島大学長　香川　　征
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36
○第８号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　微生物検査および感染制御サポートシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成27年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　検査機器は、既存の(検査情報システム)LISと直接接続し通信が可能であること。
Ｂ　指定する検査機器は既存のLISと双方向で通信できること。
Ｃ　同一菌株において，質量分析装置から得られた分析結果と薬剤感受性測定装置の分析結果は一連として結合し，自動的にその菌種に見合った解析基準により判定されること。
Ｄ　分析装置は導入予定場所に設置可能であること。